

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-287630

(43)Date of publication of application : 19.10.1999

(51)Int.CI.

G01B 11/24
H01L 21/66

(21)Application number : 10-087775

(71)Applicant : SHIN ETSU HANDOTAI CO LTD
NAGANO DENSHI KOGYO KK

(22)Date of filing : 31.03.1998

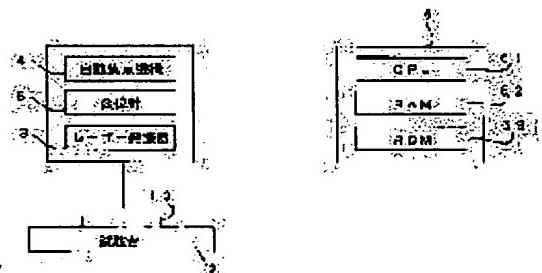
(72)Inventor : KUBOTA NORIAKI
OKABE KEIICHI

(54) SURFACE FORM MEASURING DEVICE OF SEMICONDUCTOR SUBSTRATE AND SURFACE FORM MEASURING METHOD OF SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To precisely evaluate the surface quality form and improve the production efficiency by measuring the displacement vertical to a test table surface of a semiconductor substrate surface at specified horizontal intervals, and taking the value obtained by dividing the difference between the measured displacement and the displacement measured just before by the measuring interval as a differential value to perform a calculation.

SOLUTION: An optical surface form measuring device 1 is formed of a test table 2, a laser oscillator 3, an automatic focusing mechanism 4, a displacement gauge 5 and a personal computer 6. Of the displacement data successively inputted from the displacement gauge 5, the value of the difference between the $i+1$ -th displacement data (y_{i+1}) and the displacement data just before (y_i) divided by a measuring interval ($1/100-1/10$ of the substrate diameter) is determined as a first differential value (d_{yi}). Of the first differential value (d_{yi}), the value of the difference between the $i+1$ -th displacement data and the i -th displacement data just before divided by the measuring interval is determined as the second differential value (d^2y_i), the reference deviation (s) is determined, and this value is taken as smoothness.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 07.10.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

*** NOTICES ***

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] A displacement measurement means to measure the variation rate of a perpendicular direction at the predetermined spacing horizontally to the test board front face of the semi-conductor substrate front face laid in the test board, Sequential calculation of the value which **(ed) the difference with the variation rate which carried out the sequential input of the variation rate measured by said displacement measurement means, and was measured just before the variation rate of measured 1 and the variation rate concerned of 1 by said predetermined time between measurements is carried out once as a differential value. Subsequently After carrying out sequential calculation of the value which **(ed) the difference with the 1-time differential value computed just before the 1-time differential value of computed 1, and the 1-time differential value concerned of 1 by said predetermined time between measurements as a differential value twice, The surface type-like metering device of the semi-conductor substrate characterized by having a smoothness calculation means to compute the standard deviation of a differential value as smoothness twice [said].

[Claim 2] Said predetermined time between measurements is the surface type-like metering device of the semi-conductor substrate according to claim 1 characterized by being the magnitude of 1 / 100 - 1/10 of the diameter of said semi-conductor substrate.

[Claim 3] The variation rate of a perpendicular direction is horizontally measured by predetermined time between measurements to the test board front face of the semi-conductor substrate front face laid in the test board. Subsequently The value which **(ed) the difference of the variation rate of measured 1 and the variation rate measured just before the variation rate concerned of 1 by said predetermined time between measurements is computed once as a differential value. Subsequently After computing the value which **(ed) the difference with the 1-time differential value computed just before the 1-time differential value of computed 1, and the 1-time differential value concerned of 1 by said predetermined time between measurements as a differential value twice, the standard deviation of a differential value is computed as smoothness twice [said]. Subsequently The surface type-like judging approach of the semi-conductor substrate characterized by comparing said smoothness with the distinction value prepared beforehand, and performing a predetermined judgment.

[Claim 4] Said predetermined time between measurements is the surface type-like judging approach of the semi-conductor substrate according to claim 3 characterized by being the magnitude of 1 / 100 - 1/10 of the diameter of said semi-conductor substrate.

[Translation done.]

*** NOTICES ***

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION**[Detailed Description of the Invention]****[0001]**

[Field of the Invention] This invention relates to the surface type-like judging approach of the surface type-like metering device of the semi-conductor substrate represented by the silicon wafer, and a semi-conductor substrate.

[0002]

[Description of the Prior Art] Conventionally, the silicon wafer used as a semi-conductor base ingredient is cut down by carrying out slicing of the silicon single crystal ingot by the inner circumference cutting edge or the wire saw. In recent years, high integration of the semiconductor device by fast advance of a semiconductor device technique is remarkable, and severer [the quality demand to a silicon wafer etc.] with this advance. As one of the important quality characteristics required of this silicon wafer, there is a problem of the shape of surface type of a silicon wafer. When high integration of a semiconductor device invites contraction-ization of a device dimension, for example, few waves etc. are in a silicon wafer, it is because an error arises to a device pattern in a photolithography process etc.

[0003] By the way, although there are various parameters, such as a diameter, thickness, parallelism, display flatness, camber, a wave, and surface roughness, even if it tells the configuration quality of a silicon wafer to a mouthful, what has big effect on the yield at the time of device manufacture in these is macroscopic roughness, such as display flatness, camber, and a wave, and microscopic roughness called surface roughness. Conventionally, as the evaluation approach of this macroscopic roughness, the bow shown in drawing 4 is known, for example.

[0004] The bow is a value which supports the silicon wafer 100 in a reference point, measures the distance from datum level to the midplane of the silicon wafer 100, subsequently turns the silicon wafer 100 over, measures distance similarly, and is defined by $(a-b)/2$.

[0005] Moreover, Rms (root-mean-squared roughness) as which microscopic roughness is defined for example, by the degree type is known.

[Equation 1]

$$R_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n Z_i^2}$$

Here n: The number of point of measurement, Z_i : The distance from the average surface level of the i-th point of measurement is shown. Surface type-like quality of a silicon wafer was conventionally evaluated using such an evaluation parameter.

[0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] By the way, in the wrapping process following a slicing process, as shown in drawing 5, the silicon wafer 100 is put on the lap surface plate 101,101 each other kept parallel, and the concavo-convex layer which the front rear face of the silicon wafer 100 is deleted

in this condition, and serves as microscopic roughness is removed. Although it can be made to stick to the up-and-down surface plate 101,101 when there is curvature as macroscopic roughness as shown in drawing 5 (a) at this time When there is in-between roughness between microscopic roughness and macroscopic roughness as shown in drawing 5 (b) The clearance 102 was generated between the lap surface plate 101,101 and the silicon wafer 100, the silicon wafer 100 could not break by the pressing force from [of the time of wrapping] the upper and lower sides, or it could not finish taking in wrapping, and there was a trouble that the yield fell. Especially the wire saw had the large effect by wear of a slurry etc. compared with the inner circumference cutting edge, and it was difficult for it for the variation in such in-between roughness to tend to happen, and to maintain the quality more than fixed level.

[0007] However, such in-between roughness was measured conventionally, and the attempt which it is going to evaluate quantitatively was not made but has performed the judgment by human being's organic functions chiefly about such in-between roughness.

[0008] This invention is made in view of the above-mentioned situation, and aims at offering the surface type-like judging approach of the surface type-like metering device of the semi-conductor substrate which the surface type-like quality of a semi-conductor substrate is evaluated more exactly, and can raise the productive efficiency after degree process, and a semi-conductor substrate.

[0009]

[Means for Solving the Problem] In order to solve the above-mentioned technical problem, invention according to claim 1 A displacement measurement means to measure the variation rate of a perpendicular direction at the predetermined spacing horizontally in the surface type-like metering device of a semi-conductor substrate to the test board front face of the semi-conductor substrate front face laid in the test board, Sequential calculation of the value which **(ed) the difference with the variation rate which carried out the sequential input of the variation rate measured by said displacement measurement means, and was measured just before the variation rate of measured 1 and the variation rate concerned of 1 by said predetermined time between measurements is carried out once as a differential value. Subsequently After carrying out sequential calculation of the value which **(ed) the difference with the 1-time differential value computed just before the 1-time differential value of computed 1, and the 1-time differential value concerned of 1 by said predetermined time between measurements as a differential value twice, It is characterized by having a smoothness calculation means to compute said computed standard deviation of a 2 times differential value as smoothness.

[0010] According to this invention according to claim 1, smoothness is computed, when the variation rate measured at the predetermined spacing by the displacement measurement means computes the standard deviation of a differential value twice [this] while sequential calculation of a differential value and the 2 times differential value is carried out once by the smoothness calculation means. Therefore, the in-between roughness between microscopic roughness like the conventional surface roughness and macroscopic roughness like curvature or a wave can be evaluated quantitatively, and it can judge certainly on fixed criteria compared with the case where human being has judged such in-between roughness sensuously. Namely, it is the parameter which smoothness considered the arbitrary area of the front face of a semi-conductor substrate to be a curved surface, and showed the variation in the absolute value of the rate of change of the inclination of a curved surface. By being usable as a parameter by which the middle roughness of macroscopic roughness and microscopic roughness is evaluated, and adding this smoothness as surface type-like evaluation Evaluation more positive than surface type-like evaluation of the semi-conductor substrate only by conventional surface roughness and conventional curvature can be carried out, and improvement in a yield after degree process can be aimed at. Moreover, the timing of a cutting-edge substitute of slicing can also be easily grasped by are recording of these data, and surface type-like management can be ensured even when the variation in process tolerance is a large wire saw. Moreover, since the value differentiated twice is used, the effect of disturbance, such as change of the shape of surface type with big frequencies, such as curvature, can be erased.

[0011] Here, a variation rate is defined by the distance of the perpendicular direction from a test board

front face to the front face of a semi-conductor substrate. The measuring method of this variation rate is not especially limited, although an optical thing is used in principle since the measuring range of this invention is wide, and a value may swing past the maximum in the case of a sensing-pin type.

[0012] Invention according to claim 2 is characterized by said predetermined time between measurements being the magnitude of 1 / 100 - 1/10 of the diameter of said semi-conductor substrate in the surface type-like metering device of a semi-conductor substrate according to claim 1.

[0013] According to this invention according to claim 2, since time between measurements is made into the range of 1 / 100 - 1/10, proper measurement can be performed and it becomes possible to obtain certainly the effect of the invention shown in claim 1. Here, time between measurements is determined by the magnitude of a semi-conductor substrate, and 2mm - about 40mm is the proper range as an actual value.

[0014] Invention according to claim 3 measures the variation rate of a perpendicular direction by predetermined time between measurements horizontally in the surface type-like judging approach of a semi-conductor substrate to the test board front face of the semi-conductor substrate front face laid in the test board. Subsequently The value which **(ed) the difference of the variation rate of measured 1 and the variation rate measured just before the variation rate concerned of 1 by said predetermined time between measurements is computed once as a differential value. Subsequently After computing the value which **(ed) the difference with the 1-time differential value computed just before the 1-time differential value of computed 1, and the 1-time differential value concerned of 1 by said predetermined time between measurements as a differential value twice, the standard deviation of a differential value is computed as smoothness twice [said]. Subsequently It is characterized by comparing said smoothness with the distinction value prepared beforehand, and performing a predetermined judgment.

[0015] According to this invention according to claim 3, the variation rate of a perpendicular direction is horizontally measured by predetermined time between measurements to the test board front face of the semi-conductor substrate front face laid in the test board. Subsequently The value which **(ed) the difference of the variation rate of measured 1 and the variation rate measured just before the variation rate concerned of 1 by predetermined time between measurements is computed once as a differential value. Subsequently After the value which **(ed) the difference with the 1-time differential value computed just before the 1-time differential value of computed 1 and the 1-time differential value concerned of 1 by said predetermined time between measurements is computed twice as a differential value, the standard deviation of a differential value is computed twice as smoothness. Subsequently Smoothness is compared with the distinction value prepared beforehand, and a predetermined judgment is performed. Therefore, the in-between roughness between microscopic roughness like the conventional surface roughness and macroscopic roughness like curvature or a wave can be evaluated quantitatively, and while being able to judge certainly on fixed criteria compared with the case where human being has judged such in-between roughness sensuously, the timing of a cutting-edge substitute of slicing can also be easily grasped by are recording of these data. That is, smoothness is the parameter which considered the arbitrary area of the front face of a semi-conductor substrate to be a curved surface, and showed the variation in the absolute value of the rate of change of the inclination of a curved surface, is usable as a parameter by which the middle roughness of macroscopic roughness and microscopic roughness is evaluated, by using this smoothness, rather than surface type-like evaluation of the conventional semi-conductor substrate, can carry out more positive evaluation and can aim at improvement in a yield after degree process.

[0016] Invention according to claim 4 is characterized by said predetermined time between measurements being the magnitude of 1 / 100 - 1/10 of the diameter of said semi-conductor substrate in the surface type-like judging approach of a semi-conductor substrate according to claim 3.

[0017] According to this invention according to claim 4, since time between measurements is made into the range of 1 / 100 - 1/10, proper measurement can be performed and it becomes possible to obtain certainly the effect of the invention shown in claim 3.

[0018]

[Embodiment of the Invention] The gestalt of operation of the surface type-like judging approach of the

semi-conductor substrate which used hereafter the surface type-like metering device and this equipment of the semi-conductor substrate applied to this invention with reference to drawing is explained to a detail. Drawing 1 is the block diagram having shown the important section configuration of the surface type-like metering device of the semi-conductor substrate concerning this invention. The surface type-like metering device 1 shown in drawing 1 is an optical thing, and as it is constituted by the personal computer 6 etc. and indicated in drawing 2 as the test board 2, the laser oscillation machine 3, the automatic-focusing device 4, and a displacement gage 5, it measures optically gap (y) of the distance from the reference point proofread beforehand as a variation rate.

[0019] Said test board 2 is a base which carries the silicon wafer 10 which is a non-measuring object object. Said laser oscillation machine 3 is equipment which makes laser light irradiate the front face of the silicon wafer 10 laid in said test board 2 at the predetermined spacing, and HeNe laser etc. is used for it as a laser light, for example. It can have a CCD (Charge Coupled Device) camera (illustration abbreviation), an automatic-focusing circuit (illustration abbreviation), etc., and said automatic-focusing device 4 can double now automatically the focus of the reflected image from the silicon wafer 10 of the laser light irradiated with said laser oscillation vessel 2. According to said automatic-focusing device 4, said displacement gage 5 measures the variation rate from the reference point when doubling a focus as a variation rate, and inputs it into said personal computer 6.

[0020] Said personal computer 6 is equipped with CPU (Central Processing Unit)61, RAM (Random Access Memory)62, ROM (Read Only Memory)63, etc. And said personal computer 6 inputs the displacement data outputted from said displacement gage 4, and computes the smoothness which is in-between roughness by CPU61 by making RAM62 into a working area from said displacement data which read the predetermined analyzer built in ROM63, and were inputted. This smoothness is a parameter by which the middle roughness of the microscopic roughness of the front face of the silicon wafer 10 as shown in drawing 5, and macroscopic roughness, such as camber, is evaluated, considers the arbitrary area of the front face of said silicon wafer 10 to be a curved surface, and is defined with the standard deviation value of the absolute value of the rate of change of the inclination of a curved surface.

[0021] Specifically, smoothness s is computed by the (1) type - (3) type.

[Equation 2]

$$dy_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} \quad (1)$$

$$d^2y_i = \frac{dy_{i+1} - dy_i}{dx_{i+1} - dx_i} \quad (2)$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d^2y_i - d^2\bar{y})^2} \quad (3)$$

[0022] namely, the variation rate by which a sequential input is carried out from said displacement gage 5 as shown in drawing 2 -- the i+1st variation rates among data -- data (y_{i+1}) and this y_{i+1} the i-th last variation rate -- the value which **(ed) the difference with data (y_i) by said predetermined time between measurements ($x_{i+1}-x_i$) is calculated once as a differential value (dy_i). Next, the i+1st 1-time differential values (dy_{i+1}) among said 1-time differential values (dy_i) by which sequential calculation was carried out and this dy_{i+1} The value which **(ed) the difference with the i-th last displacement data (dy_i) by said predetermined time between measurements ($x_{i+1}-x_i$) is calculated twice as a differential value (d^2y_i). And it asks for the standard deviation (s) of a differential value (d^2y_i) twice [this], and this value is made into smoothness s.

[0023] Said computed smoothness s is beforehand measured with the set-up decision value, and when

the value of smoothness s is larger than a decision value, it is judged as a defect. Here, the value which differentiated change of a variation rate twice is used as smoothness s for erasing the effect of disturbance, such as change of the shape of surface type with big frequencies, such as curvature. Here, the predetermined time between measurements (x_i) which measures displacement data (y_i) is determined by the magnitude of a semi-conductor substrate, and it is desirable that it is the magnitude of $1 / 100 - 1/10$ of the diameter of a semi-conductor substrate. if the reason will serve as a component of granularity if time between measurements is taken too much narrowly, and it is made large too much on the contrary -- surging (camber) -- it is because it expresses. Moreover, it is because the period as which the irregularity of the shape of surface type of the wafer which cut the wire saw is expressed serves as the above-mentioned range on an old experience (when sharpness is bad). Specifically, 2mm - about 40mm is the proper range.

[0024] Next, the surface type-like evaluation using the smoothness s actually computed with the surface type-like metering device 1 which gave [above-mentioned] explanation is explained. Drawing 3 is the graph having shown the surface type-like profile of the value of the smoothness s at the time of a predetermined lot, and the cutting plane at this time. The smoothness s shown in drawing 3 measures the variation rate of the front face of said silicon wafer 10 at intervals of 5mm in the cutting direction of the silicon wafer 10 cut down from the silicon single crystal ingot (illustration abbreviation) using the wire saw (illustration abbreviation). Subsequently, using this variation rate, the 1-time differential value by the aforementioned (1) formula was computed, and the 2 times differential value by the aforementioned (2) formula was computed using the differential value once [this], and subsequently, subsequently the standard deviation of a differential value was computed twice [this], and it asked.

[0025] And in the case of batch number #1, the surface type-like profile of the silicon wafer 10 at this time is [in / drawing 3] smooth [smoothness s is about about 1.0 and] as it is shown in drawing 3 . Furthermore, in the case of batch number #2 which performed slicing by the same wire saw, as smoothness s is about about 3.0 and the surface type-like profile of the silicon wafer 10 at this time is shown in drawing 3 , some irregularity is seen compared with the surface type-like profile of batch number #1, but as the shape of surface type, it is in tolerance. Then, in the case of batch number #3 which performed slicing by the same wire saw further, smoothness s is about about 6.0, and as the surface type-like profile of the silicon wafer 10 at this time was shown in drawing 3 , the in-between roughness with a period longer than it other than fine irregularity (microscopic roughness) was seen. This condition is the level which may break at the time of wrapping. And in this phase, the cutting-edge substitute of a wire saw was carried out, in the case of batch number #4 immediately after a cutting-edge substitute of a wire saw, again, smoothness s became about about 1.0 and the surface profile also became smooth.

[0026] According to the surface type-like metering device 1 concerning this invention explained above, smoothness s is computed, when the variation rate measured using laser light computes the standard deviation of a differential value twice [this] while sequential calculation of a differential value and the 2 times differential value is carried out once with a personal computer 6. Therefore, the in-between roughness between microscopic roughness like the conventional variation rate and macroscopic roughness like curvature or a wave can be evaluated quantitatively, and it can judge certainly on fixed criteria compared with the case where human being has judged such in-between roughness sensuously. Moreover, rather than surface type-like evaluation of the conventional semi-conductor substrate, more positive evaluation can be carried out and improvement in a yield after degree process can also be aimed at. Moreover, the timing of a cutting-edge substitute of slicing can also be easily grasped by are recording of these data, and surface type-like management can be ensured even when the variation in process tolerance is a large wire saw. Moreover, this smoothness is utilizable also as a parameter for the analysis of various experimental data.

[0027] In addition, in case the shape of surface type of a silicon wafer is evaluated, surface type-like evaluation of a more perfect silicon wafer can be performed by combining with other evaluation parameters called others, surface roughness, and a wave. [smoothness / this]

[0028]

[Effect of the Invention] If the effectiveness of the typical thing of this invention is explained, the variation rate measured at the predetermined spacing by the displacement measurement means With a smoothness calculation means, while sequential calculation of a differential value and the 2 times differential value is carried out once Microscopic roughness like the variation rate of the former [compute / by computing the standard deviation of a differential value twice / this / smoothness], The in-between roughness between macroscopic roughness like curvature or a wave can be evaluated quantitatively, and it can judge certainly on fixed criteria compared with the case where human being has judged such in-between roughness sensuously. That is, smoothness is the parameter which considered the arbitrary area of the front face of a semi-conductor substrate to be a curved surface, and showed the variation in the absolute value of the rate of change of the inclination of a curved surface, is usable as a parameter by which the middle roughness of macroscopic roughness and microscopic roughness is evaluated, by using this smoothness, rather than surface type-like evaluation of the conventional semi-conductor substrate, can carry out more positive evaluation and can aim at improvement in a yield after degree process. Moreover, the timing of a cutting-edge substitute of slicing can also be easily grasped by are recording of these data, and surface type-like management can be ensured even when the variation in process tolerance is a large wire saw. Moreover, since the value differentiated twice is used, the effect of disturbance, such as change of the shape of surface type with big frequencies, such as curvature, can be erased.

[Translation done.]

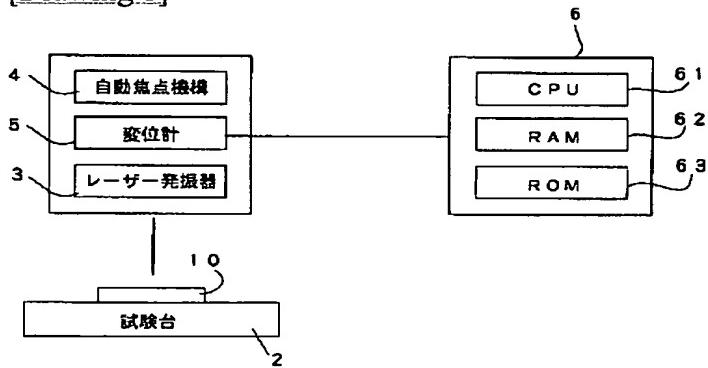
* NOTICES *

JPO and NCIPPI are not responsible for any
damages caused by the use of this translation.

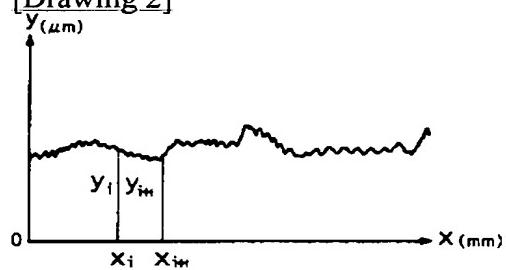
1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

[Drawing 1]



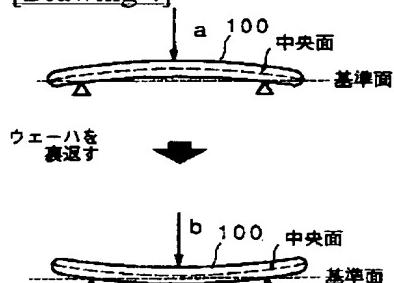
[Drawing 2]



[Drawing 3]

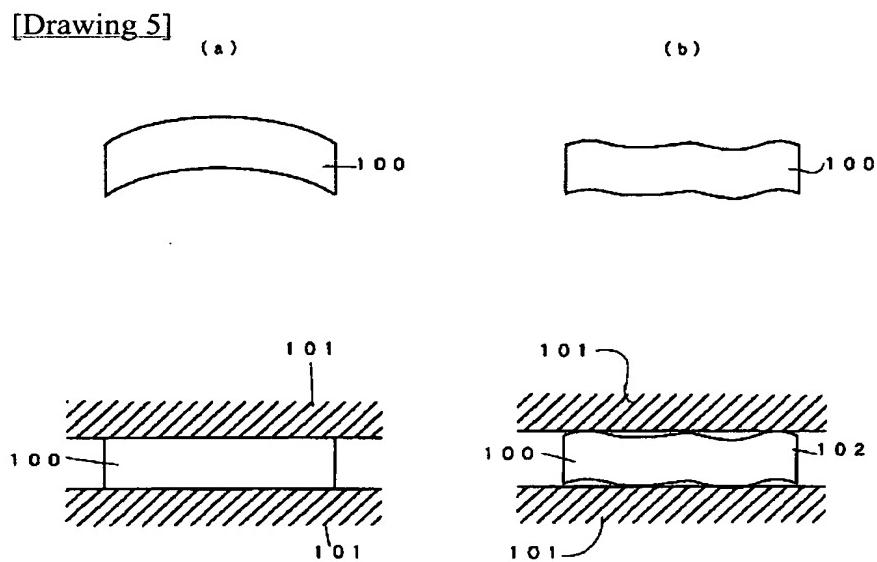
ロット	平滑度		表面プロファイル
	2.5	5	
# 1	○		
# 2		○	
# 3			○
# 4	○		

[Drawing 4]



$$\text{ボウ} = (a - b) / 2$$

[Drawing 5]



[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-287630

(43)公開日 平成11年(1999)10月19日

(51)Int.Cl.⁶
G 0 1 B 11/24
H 0 1 L 21/66

識別記号

F I
G 0 1 B 11/24
H 0 1 L 21/66

F
P

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全6頁)

(21)出願番号 特願平10-87775

(22)出願日 平成10年(1998)3月31日

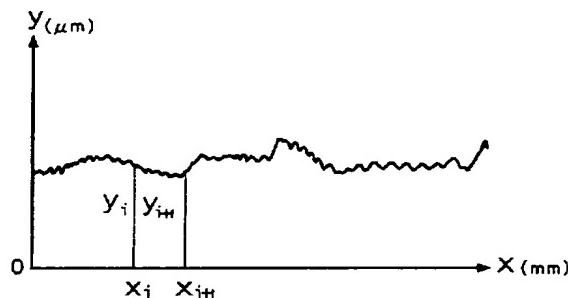
(71)出願人 000190149
信越半導体株式会社
東京都千代田区丸の内1丁目4番2号
(71)出願人 591037498
長野電子工業株式会社
長野県更埴市大字屋代1393番地
(72)発明者 久保田 慶章
長野県更埴市大字屋代1393番地 長野電子
工業株式会社内
(72)発明者 岡部 啓一
長野県更埴市大字屋代1393番地 長野電子
工業株式会社内
(74)代理人 弁理士 荒船 良男 (外1名)

(54)【発明の名称】 半導体基板の表面形状計測装置及び半導体基板の表面形状判定方法

(57)【要約】

【課題】 半導体基板の表面形状品質をより的確に評価して次工程以降の生産効率を高めることが可能な表面形状計測装置及び表面形状判定方法を提供する。

【解決手段】 試験台に載置された半導体基板の試験台表面に垂直な方向の変位を、水平方向に所定の間隔で測定する光学式の変位測定装置1(3, 4, 5)と、前記変位測定装置1により測定された変位を順次入力して、測定された一の変位と当該一の変位の直前に測定された変位との差を前記所定の測定間隔で除した値を1回微分値として順次算出し、次いで、算出された一の1回微分値と当該一の1回微分値の直前に算出された1回微分値との差を前記所定の測定間隔で除した値を2回微分値として順次算出した後、前記算出された2回微分値の標準偏差を平滑度として算出するパーソナルコンピュータ6と、を備える。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 試験台に載置された半導体基板表面の試験台表面に対して垂直な方向の変位を、水平方向に所定の間隔で測定する変位測定手段と、

前記変位測定手段により測定された変位を順次入力して、測定された一の変位と当該一の変位の直前に測定された変位との差を前記所定の測定間隔で除した値を1回微分値として順次算出し、次いで、算出された一の1回微分値と当該一の1回微分値の直前に算出された1回微分値との差を前記所定の測定間隔で除した値を2回微分値として順次算出した後、前記2回微分値の標準偏差を平滑度として算出する平滑度算出手段と、

を備えたことを特徴とする半導体基板の表面形状計測装置。

【請求項2】 前記所定の測定間隔は、前記半導体基板の直径の1/100~1/10の大きさであることを特徴とする請求項1記載の半導体基板の表面形状計測装置。

【請求項3】 試験台に載置された半導体基板表面の試験台表面に対して垂直な方向の変位を、水平方向に所定の測定間隔で測定し、

次いで、測定された一の変位と当該一の変位の直前に測定された変位との差を前記所定の測定間隔で除した値を1回微分値として算出し、

次いで、算出された一の1回微分値と当該一の1回微分値の直前に算出された1回微分値との差を前記所定の測定間隔で除した値を2回微分値として算出した後、前記2回微分値の標準偏差を平滑度として算出し、

次いで、前記平滑度と予め用意された判別値とを比較して所定の判定を行うことを特徴とする半導体基板の表面形状判定方法。

【請求項4】 前記所定の測定間隔は、前記半導体基板の直径の1/100~1/10の大きさであることを特徴とする請求項3記載の半導体基板の表面形状判定方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、シリコンウェーハに代表される半導体基板の表面形状計測装置及び半導体基板の表面形状判定方法に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、半導体基盤材料として用いられるシリコンウェーハは、シリコン単結晶インゴットを内周刃、或いはワイヤーソーによってスライシングすることにより切り出されている。近年、半導体デバイス技術の飛躍的な進歩による半導体デバイスの高集積化が著しく、この進歩に伴い、シリコンウェーハ等に対する品質要求もより厳しくなっている。かかるシリコンウェーハに要求される重要な品質特性の一つとして、シリコンウェーハの表面形状の問題がある。なぜなら、半導体デバイ

スの高集積化は、デバイス寸法の縮小化を招來し、例えば、シリコンウェーハにわずかなうねり等があった場合に、フォトリソグラフィ工程等においてデバイスバターンに誤差が生じてしまうからである。

【0003】ところで、一口にシリコンウェーハの形状品質といつても、直径、厚さ、平行度、平坦度、そり、うねり、表面粗度といった様々なパラメータがあるが、これらの中で、デバイス製造時における歩留まりに大きな影響を与えるものが、平坦度、そり、うねりといった巨視的ラフネスと、表面粗さといった微視的ラフネスである。従来、この巨視的ラフネスの評価方法としては、例えば、図4に示すボウなどが知られている。

【0004】ボウは、シリコンウェーハ100を基準点で支え、基準面からシリコンウェーハ100の中央面までの距離を測定し、次いでシリコンウェーハ100を裏返して同様に距離を測定して、(a-b)/2で定義される値である。

【0005】また、微視的ラフネスは、例えば、次式で定義されるR_{ms} (root-mean-square roughness) が知られている。

【数1】

$$R_{ms} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n Z_i^2}$$

ここで、n : 測定点数、Z_i : i番目の測定点の平均表面レベルからの距離を示す。従来はこのような評価パラメータを用いて、シリコンウェーハの表面形状品質の評価を行っていた。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】ところで、スライシング工程に続くラッピング工程においては、図5に示すように、シリコンウェーハ100は、互いに平行に保たれたラップ定盤101、101に置かれ、この状態でシリコンウェーハ100の表裏面が削られて微視的ラフネスとなる凹凸層が取り除かれる。このとき、図5(a)に示すような巨視的ラフネスとしての反りがある場合には、上下の定盤101、101に密着させることが出来るが、図5(b)に示すような微視的ラフネスと巨視的ラフネスの中間的ラフネスがある場合には、ラップ定盤101、101とシリコンウェーハ100の間に隙間102が生じ、ラッピング時の上下方向からの押付力によってシリコンウェーハ100が割れてしまったり、ラッピングでは取りきれなかったりして、歩留まりが低下するという問題点があった。特に、ワイヤーソーは、スラリーの磨耗等による影響が内周刃に比べて大きく、このような中間的ラフネスのバラツキが起こりやすく、一定レベル以上の品質を維持させることが難しかった。

【0007】しかしながら、従来は、このような中間的ラフネスを測定し、定量的に評価しようとする試みはな

されておらず、このような中間的ラフネスについては専ら人間の官能による判定を行ってきた。

【0008】本発明は、上記事情を鑑みなされたものであって、半導体基板の表面形状品質をより的確に評価して次工程以降の生産効率を高めることが可能な半導体基板の表面形状計測装置及び半導体基板の表面形状判定方法を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、請求項1記載の発明は、半導体基板の表面形状計測装置において、試験台に載置された半導体基板表面の試験台表面に対して垂直な方向の変位を、水平方向に所定の間隔で測定する変位測定手段と、前記変位測定手段により測定された変位を順次入力して、測定された一の変位と当該一の変位の直前に測定された変位との差を前記所定の測定間隔で除した値を1回微分値として順次算出し、次いで、算出された一の1回微分値と当該一の1回微分値の直前に算出された1回微分値との差を前記所定の測定間隔で除した値を2回微分値として順次算出した後、前記算出された2回微分値の標準偏差を平滑度として算出する平滑度算出手段と、を備えたことを特徴としている。

【0010】この請求項1記載の発明によれば、変位測定手段によって所定の間隔で測定された変位は、平滑度算出手段によって、1回微分値と2回微分値が順次算出されるとともに、この2回微分値の標準偏差を算出することにより平滑度が算出される。従って、従来の表面粗さのような微視的ラフネスと、反りやうねりのような巨視的ラフネスとの間の中間的なラフネスを定量的に評価することが出来ることとなって、このような中間的ラフネスを人間が官能的に判定していた場合に比べて、一定した基準で確実に判定することが出来る。即ち、平滑度は、半導体基板の表面の任意領域を曲面と考え、曲面の勾配の変化率の絶対値のバラツキを示したパラメータであって、巨視的ラフネスと微視的ラフネスの中間のラフネスを評価するパラメータとして使用可能であり、この平滑度を表面形状評価として追加することによって、従来の表面粗さと反りのみによる半導体基板の表面形状評価よりもより確実な評価をすることが可能となることとなって、次工程以降の歩留向上が図れる。また、これらデータの蓄積によってスライシングの刃替えのタイミングも容易に把握することが出来ることとなって、加工精度のバラツキが大きいワイヤーソーの場合でも表面形状管理をより確実に行うことが出来る。また、2回微分した値を用いるので、反りなどの周波数の大きな表面形状の変化などの外乱の影響を消すことが出来る。

【0011】ここで、変位は、試験台表面から半導体基板の表面までの垂直方向の距離で定義されるものである。この変位の測定方法は、本発明の測定範囲が広いので、触針式の場合、値が振り切れる可能性があるので、

原則として光学式のものを使用するが、特に限定するものではない。

【0012】請求項2記載の発明は、請求項1記載の半導体基板の表面形状計測装置において、前記所定の測定間隔は、前記半導体基板の直径の1/100~1/10の大きさであることを特徴としている。

【0013】この請求項2記載の発明によれば、測定間隔が1/100~1/10の範囲とされているので、適正な測定が出来ることとなって、請求項1に示した発明の効果を確実に得ることが可能となる。ここで、測定間隔は、半導体基板の大きさによって決定されるものであり、実際の値としては、2mm~40mm程度が適正範囲である。

【0014】請求項3記載の発明は、半導体基板の表面形状判定方法において、試験台に載置された半導体基板表面の試験台表面に対して垂直な方向の変位を、水平方向に所定の測定間隔で測定し、次いで、測定された一の変位と当該一の変位の直前に測定された変位との差を前記所定の測定間隔で除した値を1回微分値として算出し、次いで、算出された一の1回微分値と当該一の1回微分値の直前に算出された1回微分値との差を前記所定の測定間隔で除した値を2回微分値として算出した後、前記2回微分値の標準偏差を平滑度として算出し、次いで、前記平滑度と予め用意された判別値とを比較して所定の判定を行うことを特徴としている。

【0015】この請求項3記載の発明によれば、試験台に載置された半導体基板表面の試験台表面に対して垂直な方向の変位が水平方向に所定の測定間隔で測定され、次いで、測定された一の変位と当該一の変位の直前に測定された変位との差を所定の測定間隔で除した値が1回微分値として算出され、次いで、算出された一の1回微分値と当該一の1回微分値の直前に算出された1回微分値との差を前記所定の測定間隔で除した値が2回微分値として算出された後、2回微分値の標準偏差が平滑度として算出され、次いで、平滑度と予め用意された判別値とが比較されて所定の判定が行われる。従って、従来の表面粗さのような微視的ラフネスと、反りやうねりのような巨視的ラフネスとの間の中間的なラフネスを定量的に評価することが出来ることとなって、このような中間的ラフネスを人間が官能的に判定していた場合に比べて、一定した基準で確実に判定することが出来るとともに、これらデータの蓄積によってスライシングの刃替えのタイミングも容易に把握することが出来る。即ち、平滑度は、半導体基板の表面の任意領域を曲面と考え、曲面の勾配の変化率の絶対値のバラツキを示したパラメータであって、巨視的ラフネスと微視的ラフネスの中間のラフネスを評価するパラメータとして使用可能であり、この平滑度を利用することによって、従来の半導体基板の表面形状評価よりもより確実な評価をすることが可能となることとなって、次工程以降の歩留向上が図れる。

【0016】請求項4記載の発明は、請求項3記載の半導体基板の表面形状判定方法において、前記所定の測定間隔は、前記半導体基板の直径の1/100~1/10の大きさであることを特徴としている。

【0017】この請求項4記載の発明によれば、測定間隔が1/100~1/10の範囲とされているので、適正な測定が出来ることとなって、請求項3に示した発明の効果を確実に得ることが可能となる。

【0018】

【発明の実施の形態】以下、図を参照して本発明に係る半導体基板の表面形状計測装置及びこの装置を使用した半導体基板の表面形状判定方法の実施の形態を詳細に説明する。図1は、本発明に係る半導体基板の表面形状計測装置の要部構成を示したブロック図である。図1に示した表面形状計測装置1は、光学式のものであって、試験台2と、レーザー発振器3と、自動焦点機構4と、変位計5と、パーソナルコンピュータ6などにより構成され、図2に示すように、予め校正された基準点からの距離のずれ(y)を変位として光学的に測定する。

【0019】前記試験台2は、非測定対象物であるシリコンウェーハ10を載せる台である。前記レーザー発振器3は、前記試験台2に載置されたシリコンウェーハ10の表面に所定の間隔でレーザー光を照射させる装置であり、レーザー光としては、例えば、HeNeレーザー等を用いる。前記自動焦点機構4は、例えば、CCD

(Charge Coupled Device) カメラ(図示省略)、自動焦点回路(図示省略)などを備え、前記レーザー発振器2により照射されたレーザー光のシリコンウェーハ10からの反射像の焦点を自動的に合わせることが出来るようになっている。前記変位計5は、前記自動焦点機構4によって焦点を合わせたときの基準点からの変位を変位として測定し、前記パーソナルコンピュータ6に入力する。

【0020】前記パーソナルコンピュータ6は、CPU(Central Processing Unit)61、RAM(Random Access Memory)62、ROM(Read Only Memory)63などを備えている。そして、前記変位計4から出力された変位データを入力し、RAM62を作業領域として、ROM63に内蔵された所定の解析プログラムを読み出して入力された前記変位データから中間的なラフネスである平滑度をCPU61にて算出する。この平滑度は、図5に示したような、シリコンウェーハ10の表面の微視的なラフネスと、そりなどの巨視的なラフネスの中間のラフネスを評価するバラメータであり、前記シリコンウェーハ10の表面の任意領域を曲面と考え、曲面の勾配の変化率の絶対値の標準偏差値をもって定義されるものである。

【0021】具体的には、平滑度sは(1)式~(3)式によって算出される。

【数2】

$$dy_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} \quad (1)$$

$$d^2y_i = \frac{dy_{i+1} - dy_i}{dx_{i+1} - dx_i} \quad (2)$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d^2y_i - d^2\bar{y})^2} \quad (3)$$

【0022】即ち、図2に示すように、前記変位計5から順次入力される変位データのうち、i+1番目の変位データ(y_{i+1})と、この y_{i+1} の直前のi番目の変位データ(y_i)との差を前記所定の測定間隔($x_{i+1} - x_i$)で除した値を1回微分値(dy_i)として求め。次に、順次算出された前記1回微分値(dy_i)のうち、i+1番目の1回微分値(dy_{i+1})と、この $d y_{i+1}$ の直前のi番目の変位データ(dy_i)との差を前記所定の測定間隔($x_{i+1} - x_i$)で除した値を2回微分値(d^2y_i)として求める。そして、この2回微分値(d^2y_i)の標準偏差(s)を求め、この値を平滑度sとしている。

【0023】前記算出された平滑度sは、予め、設定された判定値と比較され、平滑度sの値が判定値よりも大きい場合には、不良として判定されるようになっている。ここで、平滑度sとして、変位の変化を2回微分した値を用いるのは、反りなどの周波数の大きな表面形状の変化などの外乱の影響を消すためである。ここで、変位データ(y_i)を測定する所定の測定間隔(x_i)は半導体基板の大きさによって決定されるものであり、半導体基板の直径の1/100~1/10の大きさであることが望ましい。その理由は、測定間隔を狭く取りすぎると粗さの成分となり、反対に広くしすぎるとうねり(そり)を表してしまうからである。また、ワイヤーソーを切断したウェーハの表面形状の凹凸の表される周期(切れ味が悪い時)が今までの経験上、上記の範囲となっているためである。具体的には、2mm~40mm程度が適正範囲である。

【0024】次に、上記説明した表面形状計測装置1により実際に算出した平滑度sを用いた表面形状評価について説明する。図3は、所定のロット時における平滑度sの値と、このときの切断面の表面形状プロファイルを示した図表である。図3に示した平滑度sは、ワイヤーソー(図示省略)を用いてシリコン単結晶インゴット(図示省略)から切り出したシリコンウェーハ10の切断方向に5mm間隔で前記シリコンウェーハ10の表面の変位を測定し、次いで、この変位を用い、前記(1)式による1回微分値を算出し、次いで、この1回微分値を用い、前記(2)式による2回微分値を算出し、次い

で、この2回微分値の標準偏差を算出して求めた。

【0025】そして、図3において、例えば、ロットナンバー#1の場合には、平滑度sが約1.0程度であり、このときのシリコンウェーハ10の表面形状プロファイルは図3に示す通り滑らかである。さらに、同一ワイヤーソーでスライシングを行ったロットナンバー#2の場合には、平滑度sが約3.0程度であり、このときのシリコンウェーハ10の表面形状プロファイルは図3に示すように、ロットナンバー#1の表面形状プロファイルに比べて多少の凹凸が見られるが、表面形状としては許容範囲内である。続いて、更に同一ワイヤーソーでスライシングを行ったロットナンバー#3の場合には、平滑度sが約6.0程度であり、このときのシリコンウェーハ10の表面形状プロファイルは、図3に示すように、細かい凹凸（微視的ラフネス）の他に、それよりも周期の長い中間的なラフネスが見られた。この状態は、ラッピング時に割れる可能性があるレベルである。そして、この段階で、ワイヤーソーの刃替えを実施し、ワイヤーソーの刃替え直後のロットナンバー#4の場合、再び平滑度sは、約1.0程度となって、表面プロファイルも滑らかになった。

【0026】以上説明した本発明に係る表面形状計測装置1によれば、レーザー光を用いて測定した変位は、パソコン用コンピュータ6によって、1回微分値と2回微分値が順次算出されるとともに、この2回微分値の標準偏差を算出することにより平滑度sが算出される。従って、従来の変位のような微視的ラフネスと、反りやうねりのような巨視的ラフネスとの間の中間的なラフネスを定量的に評価することができることとなって、このような中間的なラフネスを人間が官能的に判定していた場合に比べて、一定した基準で確実に判定することができる。また、従来の半導体基板の表面形状評価よりもより確実な評価をすることができるようになって、次工程以降の歩留向上も図れる。また、これらデータの蓄積によってスライシングの刃替えのタイミングも容易に把握することができることとなって、加工精度のバラツキが大きいワイヤーソーの場合でも表面形状管理をより確実に行うことができる。また、この平滑度は、種々の実験データの解析用のパラメータとしても活用出来る。

【0027】なお、シリコンウェーハの表面形状を評価する際には、本平滑度の他、表面粗さやうねりといった他の評価パラメータと組み合わせることにより、より完全なシリコンウェーハの表面形状評価が出来る。

【0028】

【発明の効果】本発明の代表的なものの効果について説

明すれば、変位測定手段によって所定の間隔で測定された変位は、平滑度算出手段によって、1回微分値と2回微分値が順次算出されるとともに、この2回微分値の標準偏差を算出することにより平滑度が算出されることから、従来の変位のような微視的ラフネスと、反りやうねりのような巨視的ラフネスとの間の中間的なラフネスを定量的に評価することができることとなって、このような中間的なラフネスを人間が官能的に判定していた場合に比べて、一定した基準で確実に判定することができる。即ち、平滑度は、半導体基板の表面の任意領域を曲面と考え、曲面の勾配の変化率の絶対値のバラツキを示したパラメータであって、巨視的ラフネスと微視的ラフネスの中間のラフネスを評価するパラメータとして使用可能であり、この平滑度を利用することによって、従来の半導体基板の表面形状評価よりもより確実な評価をすることができるようになって、次工程以降の歩留向上が図れる。また、これらデータの蓄積によってスライシングの刃替えのタイミングも容易に把握することができることとなって、加工精度のバラツキが大きいワイヤーソーの場合でも表面形状管理をより確実に行うことができる。また、2回微分した値を用いるので、反りなどの周波数の大きな表面形状の変化などの外乱の影響を消すことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る半導体基板の表面形状計測装置の要部構成を示したブロック図である。

【図2】本発明に係る平滑度を算出する方法を説明するための図である。

【図3】所定のロットにおける平滑度と、このときのシリコンウェーハ切断面の表面形状プロファイルを示した図表である。

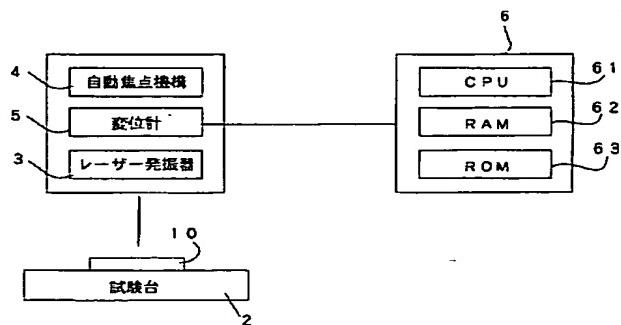
【図4】従来のボウを算出する方法を説明するための図である。

【図5】ラッピング時におけるシリコンウェーハの表面形状の及ぼす影響を模式的に示した図である。

【符号の説明】

- | | |
|-----|----------------------|
| 1 | 表面形状計測装置 |
| 2 | 試験台 |
| 3 | レーザー発振器（変位測定手段） |
| 4 | 自動焦点機構（変位測定手段） |
| 5 | 変位計（変位測定手段） |
| 6 | パソコン用コンピュータ（平滑度算出手段） |
| 6.1 | CPU |
| 6.2 | RAM |
| 6.3 | ROM |

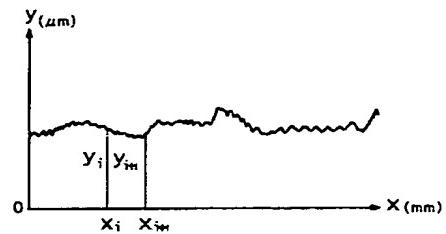
【図1】



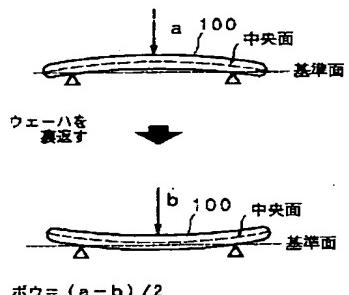
【図3】

ロット	平滑度		表面プロファイル
	2.5	5	
# 1	○		
# 2		○	
# 3			○
# 4	○		

【図2】



【図4】



【図5】

(a)



(b)

